PASJ2014-SUP083

cERL 高速ロスモニタ用検出系のテスト

TEST OF DETECTION UNIT FOR THE CERL HIGH-SPEED LOSS MONITOR

下ヶ橋秀典^{#, A)}, 帯名崇^{A)}, 多田野幹人^{A)} Hidenori Sagehashi^{#, A)}, Takashi Obina^{A)}, Mikito Tadano^{A)} ^{A)} High Energy Accelerator Research Organization

Abstract

In the High Energy Accelerator Research Organization (KEK), ERL (Energy Recovery Linac) which is a nextgeneration synchrotron orbital radiation light source is studied. Now, at KEK, various researches and technical development are performed by compact ERL (cERL) built for technical verification of ERL. Loss monitor development for protecting accelerator apparatus from damage by the beam collision of high energy as one of the interlocks for apparatus protection in it is performed. This loss monitor needs to stop a beam at high speed at the time of beam operation by high intensity (high current). This time, it tested by putting a sensor and a scintillator into the actual cERL accelerator interior of a room. As for these sensors and a scintillator, use by high-speed loss monitor is considered. Since implementability as a high-speed loss monitor was examined based on the test result, it is reported.

1. はじめに

インターロック用高速ロスモニタの検出部として 使用可能なセンサとして光電子増倍管(PMT)があ る。PMTとは光電効果を利用して光エネルギーを電 気エネルギーに変換する光電管に、電流増幅機能を 付加した高感度光検出器である。これを用い、シン チレータの有無、プリアンプの設置位置、シンチ レータの種類、高電圧(HV)設定値のテストを行い、 ERL 用高速ロスモニタ検出部のシステム構成を検討 した。

2. 光電子増倍管とプリアンプ

本今回のテストに使用した PMT は浜松ホトニクス 社製の高利得で低暗電流のものを使用した。代表的 な仕様を Table 1^[1]に示す。

Table 1:	PMT S	pecifications
----------	-------	---------------

Parameter	Description/Value
Size	φ 28.5 mm
Туре	Side-on
Spectral Response	300 to 650 nm
Photocathode Material	Bialkali
Photocathode Area	8×24 mm
Dynode Number of stage	9
Maximum Supply Voltage	1250V(A-C)

また、今回のテストに使用したプリアンプは PMT と同様に浜松ホトニクス社製のものを使用した。代 表的な仕様を Table 2^[2]に示す。

hidenori.sagehashi@kek.jp

Table 2: AMP Specifications

Parameter	Description/Value	
Frequency Bandwidth(-3db)	DC to 150MHz	
Voltage Gain	38dB(80times)	
Current-Voltage Factor	$4mV/\mu A(50\Omega)$	
Rise Time (Typ.)	2.3ns	
Maximum Output Voltage	$\pm 1.4 V(50 \Omega)$	

3. 機器の配置とテストビーム

Figure 1 に機器の配置図を示す。テストは KEK の cERL を用いて行われた。オシロスコープおよび高 電圧電源装置は加速器室外の計測ラックに設置し、 センサ類(PMT、シンチレータ(CsI))およびプリア ンプは加速器室内のスクリーンモニタ(SCM)の近 傍に設置した。SCM は破壊型ビームモニタであり、 スクリーン挿入時に発生するビームロスを用いてロ スモニタのテストを行った。センサ類は厚紙で作ら れた暗箱に納められており、その箱は遮光されてい る(Figure 2)。センサ類設置位置から計測ラックまで はケーブル長で 50m離れている。加速器室内のセン サ類設置状況を Figure 16(本文最後)に示す。

テストに使用したビームの仕様はバースト (パル ス)モード、エネルギー5.6MeV、ピーク電流 1mA、 平均電流 5nA、パルス幅 1 µ s である。ロス状態とは 先にも述べたとおり、ビームが ON でセンサ近傍の SMC のスクリーンが挿入された状態であり、ロス無 し状態とはビームが ON でスクリーンが挿入されて いない状態の時である。 **PASJ2014-SUP083**



Figure 1: Placement of equipment.

シンチレータについて 4.

シンチレータはCsI (13×13×25mm) を13×13の 面をPMTの光電面に密着させて使用した。ただし、 シリコンオイル、接着剤等は使用していない。その 他の 5 面は白いテフロンテープを巻き、反射光を得 るようにした。PMT と Csl シンチレータの暗箱収納 の様子を写真1に示す。CsIの種類は不明であるが、 観測結果等から PureCsI であると思われる。

4.1 シンチレータ無し

シンチレータを用いると、シンチレータ自身の経 年変化(放射線による劣化、湿度による影響)が心 配される。そのため、シンチレータ無しでロスモニ タとして使えるかテストをした。シンチレータは取 り外された状態でテストを行った。Figure 3,4 に結果 を示す。発光源が無いので、出力を得るために HV の値を-800V に設定した。ロス状態を検出すること は確認できたが、高い HV 設定値によりゲインが高 くなる^[3]ため、ロス無し状態でも目的以外の出力が 多く出力された。そのため、誤検出が頻発される懸 念が生じる。

4.2 シンチレータ有り

Figure 5.6 に結果を示す。発光源があるため、ロス 状態の時は出力が大きく得られ、HV 設定値を-400V



Figure 3: No scintillator, On loss.(HV=-800V)



Figure 5: With scintillator, Figure 6: With scintillator, On loss.(HV=-400V)



Figure 4: No scintillator, No loss.(HV=-800V)

I	H:200n	s/div	V:20	0mV/	'div
- 241.4				1752	ar lar
200					-

No loss.(HV=-400V)



Figure 2: Preparation of sensors.

に設定しても良好な出力が得られた。立ち上がりも 100ns 程度と高速ロスモニタとして期待できる。シ ンチレータがあると HV 設定値は低く抑えられるた め、目的以外の出力は非常に低減される。ロス無し 状態での出力はほとんど無く、誤検出の可能性が低 いと言える。

4.3 シンチレータの種類

PureCsI に比べ発光強度の大きいシンチレータ CsI(Tl)を用いてテストを行った。シンチレータのサ イズは10×10×3mmで10×10の面をPMTの光電面 に密着させて使用した。他の条件は CsI と同様とし た。Figure 7 に結果を示す。結晶のサイズが異なる こと、ロスの時間幅が1µsであり、波形の立ち上が りが1µs内に収まらなかったことで、強度の比較は 出来なかったが、CsI に比べて結晶サイズが小さい にもかかわらず、出力信号が大きくなることを確認 した(HV=-400V)。ただし、波形の立ち上がり時 間が遅いため、今回の高速動作を必要とするロスモ ニタには使用が不向きである。

av a saysa	H:	200	ns/d	liv	V:2	.00n	ıV/	div
200	_						142	
		~	<u>.</u>					212 112
				100				a sa ta
					Co Marco		e ^{lK}	

Figure 7: Change to CsI (Tl), On loss.(HV=-400V)

PMT の HV 設定値について 4.

PMT の HV 値を変化させたときの出力信号の波形 観測結果を Figure 8-12 に示す。波形観測から得られ た HV 設定値と信号出力の関係を Figure 13 に示す。 今回のビームロス量では HV 設定値が-300V~-450V までほぼリニアに出力電圧が変化している。-450V から信号出力が頭打ちになるのは、プリアンプの最 大出力電圧が±1.4Vのため、そこで制限がかかった ためである。HV 値を大きくすると、PMT のゲイン が上がり、少ないロス量を検出するときに良いが、 HV 値を上げ過ぎると、4.1 シンチレータ無しのテス トの時にも述べたように、目的以外の出力が多く出 力されるため、誤検出の可能性が高くなるので注意

が必要である。テストを行って来た結果、インター ロック用のロスモニタとして使用する場合、HV 設 定値は-600V~-700V 程度までとした方が良いと思わ れる。





Figure 9: HV=-350V

With scintillator, On loss.

Figure 8: HV= -300V With scintillator,On loss.

angenetic	H:200ns/	/div V:2001	mV/div
12			
			And the second s
	h		Record and the second s
		and the second secon	
			43

H:200ns/div V:200mV/div

Figure 11: HV= -450V

With scintillator, On loss.

Figure 10: HV= -400V With scintillator,On loss.

angentin	H:200ns/div V:200mV/div
- 200 - 200	Here and Annual
-0102	
-96220 83	
100 BKD	1 1941 4596 969 4596 13 13/4 197 137

Figure 12: HV= -500V With scintillator,On loss.

5. プリアンプの位置について

プリアンプはセンサ類近傍にあった方が、加速器 室外の遠く離れた測定器に信号を送るためには S/N は有利である。しかし、当然のことながらロスモニ タのセンサ類は放射線場で使用するため、可能であ ればアンプ等の半導体を使用した電子機器類は放射 線損傷をさけるため、加速器室内の設置を避けたい。 そこで、PMT のプリアンプをセンサ類側では無く、 50m 離れた計測ラック側に設置してテストを行った。 結果を Figure 14,15に示す。ノイズもしくは他の機器 の影響で 1/3 程度不要な波形が重畳している。微弱 な信号を長距離伸ばしたため、外乱の影響が無視で



Figure 14: Away AMP, On loss.(HV=-400V)

Figure 15: Away AMP, No loss.(HV=-400V)



Figure 13: HV - Signal OUT, On loss.

きなくなった。ノイズ低減等の処置を行えば加速器 室外での使用が実現可能かもしれないが、現状では 難しいと考える。

5. まとめ

今回のテスト結果から Figure 1 のような機器配置 で高速ロスモニタを構築していくこととした。プリ アンプが加速器室内に設置されてしまうが、今回の テストでも PMT からプリアンプまで 2m のケーブル で接続している。2m あればビームダクトから離す ことが出来る。必要であれば遮蔽等の対策も講じる ことが可能である。

Pure CsI のシンチレータを用いれば 100ns~程度の時間でロスを検出することが可能であると確認できた。HV 設定値によるゲイン調整と検出信号の閾値によって、ロスの警報発報レベルを制御可能であることを確認した。

今後は今回のテストを参考にして、高速ロスモニ タの信号処理(警報出力)および警報発報システム を開発してゆく予定である。

参考文献

- [1] http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/ R11558_TPMS1078E01.pdf
- [2] http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/ C9663_TACC1046E02.pdf
- [3] http://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/ PMT_handbook_v3aJ-Chapter4.pdf



Figure 16: Apparatus installation situation.